

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 6 部門第 4 区分  
 【発行日】平成 19 年 1 月 25 日 (2007.1.25)

【公開番号】特開 2004-199858 (P2004-199858A)  
 【公開日】平成 16 年 7 月 15 日 (2004.7.15)  
 【年通号数】公開・登録公報 2004-027  
 【出願番号】特願 2003-416567 (P2003-416567)  
 【国際特許分類】

**G 1 1 B 9/14 (2006.01)**

**G 1 1 B 9/04 (2006.01)**

【F I】

G 1 1 B 9/14 A

G 1 1 B 9/14 G

G 1 1 B 9/04

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 12 月 4 日 (2006.12.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

データ記憶装置であって、  
 導電性を有する第 1 のポリマー層と該第 1 のポリマー層上の第 2 のポリマー層とを含む記憶媒体と、  
 前記第 2 のポリマー層に面する接触プローブと  
 を含む、データ記憶装置。

【請求項 2】

前記接触プローブが、書き込み動作時に前記第 2 のポリマー層にトポロジー変化を生成する、請求項 1 に記載のデータ記憶装置。

【請求項 3】

前記第 2 のポリマー層が導電性を有し、前記トポロジー変化が前記第 2 のポリマー層における窪みを含み、該窪みが前記第 1 のポリマー層まで延びない、請求項 2 に記載のデータ記憶装置。

【請求項 4】

前記第 2 のポリマー層が非導電性を有し、前記トポロジー変化が前記第 2 のポリマー層におけるスルーホールを含む、請求項 2 に記載のデータ記憶装置。

【請求項 5】

前記第 1 のポリマー層が、前記第 2 のポリマー層よりも高いガラス転移温度を有する、請求項 1 に記載のデータ記憶装置。

【請求項 6】

前記第 1 のポリマー層が導電層として機能する、請求項 1 に記載のデータ記憶装置。

【請求項 7】

前記プローブと前記第 1 のポリマー層との間に接続されて前記第 2 のポリマー層の抵抗値の変化を測定する回路を更に含む、請求項 6 に記載のデータ記憶装置。

【請求項 8】

前記第 1 のポリマー層を支持するための基板を更に含み、該基板の導電率が前記第 1 の

ポリマー層の導電率よりも数桁だけ高い、請求項 1 に記載のデータ記憶装置。

【請求項 9】

前記プローブと前記基板との間に接続されて前記第 2 のポリマー層の抵抗値の変化を測定する回路を更に含む、請求項 8 に記載のデータ記憶装置。

【請求項 10】

接触プローブ型記憶装置のための記憶媒体であって、基板と、該基板上の第 1 のポリマー層と、該第 1 のポリマー層上の第 2 のポリマー層とを含み、該第 1 のポリマー層が導電性を有する、接触プローブ型記憶装置のための記憶媒体。

【請求項 11】

前記第 1 のポリマー層が、前記第 2 のポリマー層よりも高いガラス転移温度を有する、請求項 10 に記載の記憶媒体。

【請求項 12】

前記第 1 のポリマー層が導電層として機能する、請求項 10 に記載の記憶媒体。

【請求項 13】

前記基板の導電率が前記第 1 のポリマー層の導電率よりも数桁だけ高い、請求項 10 に記載の記憶媒体。